

(f) Int. Cl.<sup>6</sup>:

H 05 H 1/36

H 01 J 37/34 H 01 L 21/203

C 23 C 14/34

## (19) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES PATENTAMT** 

## Offenlegungsschrift <sup>®</sup> DE 19651811 A 1

196 51 811.3 13. 12. 96

(43) Offenlegungstag: 18. 6.98

(1) Aktenzeichen:

② Anmeldetag:

Corresponding to

US 6,096,174

(7) Anmelder:

Leybold Systems GmbH, 63450 Hanau, DE

(72) Erfinder:

Szczyrbowski, Joachim, Dr., 63773 Goldbach, DE; Teschner, Götz, 63450 Hanau, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE 195 06 515 C1 DE 195 06 513 C2 DE 44 38 463 C1 DE 42 42 633 C2 42 37 517 A1 DE 42 02 425 A1 DE DE 40 42 287 A1 DD 2 52 205 A1 US 52 41 152 49 02 394

## Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- Vorrichtung zum Belegen eines Substrats mit d\u00fcnnen Schichten
- Bei einer Vorrichtung zum Belegen eines Substrats (24) mit dünnen Schichten von Targets (12, 13), zwischen denen ein Gasentladungsplasma aufrechterhalten wird, um die zum Beschuß der an Wechselspannung anliegenden Targets (12, 13) erforderlichen Ionen zu erzeugen, enthält die Prozeßkammer (6) ein unter einem bestimmten Partialdruck stehendes Gas, wobei die Targets (12, 13) mit einer Stromquelle (3) verbunden und so geschaltet sind, daß sie wechselweise Kathode und Anode der Gasentladung bilden. Das Umpolen der Stromrichtung erfolgt dabei über eine aus vier Schaltern (16 bis 19) gebildete H-Brücke (4), wobei der die H-Brücke (4) mit einer ersten Stromquelle (3) verbindende Stromleiter (14) über eine Zweigleitung (21) mit einer zweiten, über einen Schalter (20) mit Erde verbindbaren Stromguelle (5) verbunden ist und alle Schalter (19 bis 20) von einer Steuerschaltung in einem regelmäßigen und einstellbaren Modus betätigt werden, wobei die Ionenenergie durch die Höhe des Potentialunterschieds zwischen der Kathode und der Schicht und die Ionenzahl durch die Zeitdauer dieses Potentials kontrollierbar sind.

